
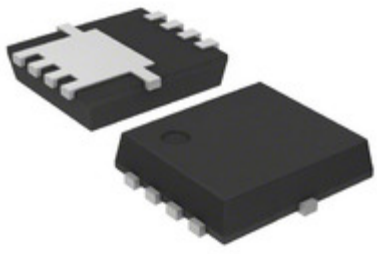




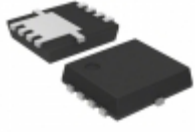



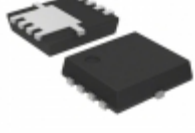


| | |
|---|--|
|  | <h2 style="color: #E67E22;">RQ3E180BNTB</h2> |
|  | Hersteller-Teilenummer: RQ3E180BNTB |
| | Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor |
| | Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 18A 8HSMT |
| | Datenblätter:  RQ3E180BNTB.pdf |
| | RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: New original, Stock Available. |
| Liefern von: Hong Kong | |
| Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | RQ3E180BNTB |
| Hersteller | LAPIS Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 30V 18A 8HSMT |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.5V @ 1mA |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-HSMT (3.2x3) |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 3.9 mOhm @ 18A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 2W (Ta), 20W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 8-PowerVDFN |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 3500pF @ 15V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 72nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 18A (Ta), 39A (Tc) |

RQ3E180BNTB Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RQ3E180BNTB-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RQ3E180BNTB LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ RQ3E180BNTB E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>RQ3E160ADTB1 ROHM/ RQ3E160ADTB1 ROHM/</p> |  <p>RQ3E160ADTB Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 16A 8HSMT</p> |  <p>RQ3E180GN QQ2850920316 RQ3E180GN QQ2850920316</p> |  <p>RQ3E180BN QQ2850920316 RQ3E180BN QQ2850920316</p> |
|  <p>RQ3G100GN ROHM RQ3G100GN ROHM</p> |  <p>RQ3G100GN Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 40V 10A TSMT</p> |  <p>RQ3G150GN Rohm Semiconductor NCH 40V 30A POWER MOSFET</p> |  <p>RQ3E160ADM6 ROHM/ RQ3E160ADM6 ROHM/</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|
| RQ3E180BNTB LAPIS Semiconductor | RQ3E180BNTB Datenblatt | RQ3E180BNTB-Datenblätter | RQ3E180BNTB PDF | LAPIS Semiconductor RQ3E180BNTB |
| RQ3E180BNTB Electronic | RQ3E180BNTB-Komponenten | RQ3E180BNTB-Verteiler | RQ3E180BNTB-Bild | RQ3E180BNTB-Teil |
| RQ3E180BNTB Preis | RQ3E180BNTB Hersteller | RQ3E180BNTB Bild | RQ3E180BNTB Aktie | RQ3E180BNTB Inventar |
| RQ3E180BNTB Neu | RQ3E180BNTB Original | RQ3E180BNTB garantiert | RQ3E180BNTB RFQ | RQ3E180BNTB Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited